










	<h2 style="color: red;">FDP120AN15A0</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDP120AN15A0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDP120AN15A0.pdf  2.FDP120AN15A0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 18500 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP120AN15A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 2.8A (Ta), 14A (Tc) 65W (Tc)
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	65W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Ta), 14A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	770pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP120AN15A0 ist neu im Original, Suche FDP120AN15A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP120AN15A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP120AN15A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP120AN15A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB	 FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220	 FDP120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220	 FDP11N50 FSC FSC TO-220
 FDP10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB	 FDP10AN06AO Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06AO FAIRCHILD	 FDP12N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220	 FDP10N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220

heiße Teile

Mehr

FDP060AN08A0	FDP060AN08AO	FDP060N08A0	FDP060N08AO	FDP068AN08A0
FDP070AN06A0	FDP070AN06AO	FDP070AN06AO	FDP075N15A	FDP075N15A
FDP083N15A	FDP083N15A	FDP083N15A_F102	FDP085N10A	FDP085N10A
FDP085N10A_F102	FDP090N10	FDP090N10	FDP100N10	FDP100N10
FDP10AN06A0	FDP10AN06AO	FDP10AN06AO	FDP10N60NZ	FDP10N60NZ
FDP120AN15A0	FDP120AN15A0	FDP120N10	FDP12N50	FDP12N50
FDP12N50	FDP12N50NZ	FDP12N50NZ	FDP12N60NZ	FDP12N60NZ
FDP13AN06A0	FDP13AN06AO	FDP13AN06AO	FDP14AN06LA0	FDP14AN06LA0
FDP14AN06LA0	FDP14N60	FDP150N10	FDP150N10	FDP150N10A
FDP150N10A	FDP150N10A_F102	FDP15N40	FDP15N40	FDP15N50

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited